Nd/Yb hybrid amplifier laser system of RF gun for SuperKEKB

SuperKEKB に向けた RF 電子銃用 Nd/Yb ハイブリッドレーザーシステム

周 翔宇#), 夏井 拓也, 張 叡, 吉田 光宏, 小川 雄二郎

Xiangyu Zhou^{#)}, Takuya Natsui, Rui, Zhang, Mitsuhiro Yoshida, Yujiro Ogawa

High Energy Accelerator Research Organization (KEK/SOKENDAI)

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

Abstract

For RF gun of injector linac, by development of the Yb-doped laser system, more than 1.0 nC electron has been obtained in 25 Hz. The Yb-doped laser system is already for commissioning phase I. Next, to generate 50 Hz double bunch electron beam, a new Nd/Yb hybrid laser system is development to improve the stability and pulse energy.

1. 背景

SuperKEKB の設計ルミノシティは KEKB で最終的に到達したルミノシティの約 40 倍である。 KEKB の熱カソード DC 銃が 20 mm-mrad 5 nC という高電荷低エミッタンスを達成するのは非常に困難であるので、SuperKEKB ではフォトカソード RF 電子銃を使用することになった。ただいま、RF 電子銃の導入やレーザー光源の増強など、入射器の改造も進行中である。

SuperKEKB の建設は順調に進み、今年、第一 段階のビームコミッショニング (Phase I) を開始し た[1]。この期間には RF 電子銃 と KEKB 時代から 使用している熱電子銃と並行して運転を行う。RF 電子銃に向けて 25 Hz Yb 系ファイバーおよび Yb:YAG Thin-disk 増幅媒質とするハイブリッド増幅 システムを開発した。Phase I 運転においては、1 nC 程度のバンチ電荷量で満足できる。このレー ザーを使ったシングルバンチ、25 Hz、1.3 nC の電 子源を生成され、ビームコミッショニングを行って いる。

その後、今秋に第二段階のビームコミッショニ ング(Phase II)に進んで衝突点での絞り込み及び 衝突ビーム調整を行い、5 nC 程度のバンチ電荷量 が必要である。したがって、Nd と Yb ドップ利得媒 質を用い、新しいハイブリットレーザーシステムを 開発している。

2. 25Hz Yb ハイブリッドレーザー光源

2.1 レーザーシステム

Phase I 運転においては、1 nC 程度の安定なビー ム開発に集中する。RF 電子銃用 Yb ハイブリッド レーザーシステムの開発はほぼ完成した[2]。

Figure 1 のよう、まず Yb ドップファイバー発振 器から 51.9 MHz の種光パルスを生成して、Linac の 2856 MHz 主トリガーによって同期を行った。コア 径 4 µm の Yb ドップファイバーを用いて、750 mW のポンプレーザーダイオード(LD)と WDM(wavelength division multiplexed coupler)を溶接 し、種光を増幅した。そして、パルスを透過型回折 格子ストレッチャーにより~30 ps まで伸ばし、パル スのスペクトルを矩形に整形した。



Figure 1: Layout of Laser system.

半導体光増幅(semiconductor optical amplifier: SOA) は高速光スイッチ(切り替え速度~lns)でパルス ピッカーとして使用する。繰り返し周波数 51.9 MHz のパルス列を 10.38 MHz に下げると同時に増 幅によって利得が得られた。

さらに、弱いパルスを増幅するため、ポンプパ ワーを3 つに分けて(15%、35%、50%)、3 段ア ンプを行った。そして、コア径40 µm、長さ1.2 m の大口径 Yb フォトニック結晶ファイバー(PCF) を用い、波長976 nmのLD 励起光によって増幅を 行う。増幅したパルスは電気光学効果(EO)パル スピッカーによりを低繰り返しに変更した。µJピー ク強度を得るためもう一段階同じ構造PCFファイ バー増幅を行った。ポンプ光源の出力を安定化する ため、波長940 nmのLD 励起光を用いた。

低繰り返し、高強度増幅するため Yb:YAG thindisk 結晶を用いて、マルチパス共振器増幅及び 3 段 階のマルチパス増幅による多重アンプを行った。 ディスクレーザーには結晶を薄くディスク状にして, 冷却装置への設置面積を広くした。いろんなテスト の結果として、結晶厚み 05 mm に対して 25 Hz 繰り 返しパルス増幅を対応できる。最後に、2 段階の第 2 高調波発生(SHG)により sub-mJ レベル紫外超短 光源が得られた。

ポンプ光源の繰り返す周波数を固定すると、熱影響とシステム条件も一致なので、シグナル光の繰り 返す周波数を 25 Hz 以下に自由に切り替えることも 実現できた。長時間安定な運転するため、基本波出 カエネルギーは 7 mJ 程度を抑えている。RF 電子銃 前に紫外パルスエネルギーが約 400 µJ 得られた。

2.2 レーザー光源の安定性

昨年、25 Hz 繰り返しに対して 1 nC の電子ビーム を得たが、室温および冷却システムによる熱蓄積が 熱レンズ効果を引き起こし、レーザー安定性などの 問題が残った。それらの問題を完全に解決し、1 か 月以上レーザーが連続運転によって、長時間安定性 をテストした。





Figure 2 は、4 月 26 日から 6 月 9 日の間にレー ザー光源の出力エネルギーを観測した。4 月 27 日 に最後のレーザーメンテナンスを行って、その後全 レーザーシステムを 6 月 9 日までノータッチしてい た。途中、何回に外部トリガーがなくなり、レー ザーシグナルを 0 になることがある。その場合には、 全てのレーザーポンプダイオードが運転し続く、熱 条件が変化しない。外部トリガーを回復したら、 レーザーの出力も元に復旧した。1 か月以上にレー ザー光源が安定に働くことが確認した。

更に、レーザーハットの中にエレベーター点検を 月一回に行うので、すべでのレーザーポンプダイ オードを半日くらいシャットダウンした。その後、 再び電源を入れるとレーザーが完全に復旧したこと も確認した。

2.3 レーザーパルス幅および電荷量

透過型回折格子ストレッチャーを用い、パルスス ペクトルを調整することで Sub-30ps 矩形パルスを 整形する。回折格子間の距離を調整し、回折格子対 の後に空間マスクを設置して、パルスの時間幅を調 節した。Figure 3 によって、パルスの時間幅をスト リークカメラで測った。パルス幅が約 28 ps であり、 矩形になるように整形した。



Figure 3: Pulse shape by streak camera.

また、レーザー光源を用いて RF 電子銃から電子 ビームを生成した。1.3 nC、25 Hz、シングルバンチ 電子発生を確認している[3]。Q Scan によって、エ ミッタンスは水平方向:28.3 mm-mrad、垂直方向: 26.4 mm-mrad の結果になった。このレーザーシステ ムは Phase I 運転条件を満たしたので、ビームコ ミッショニングを行っている。

新 Nd/Yb ハイブリッドレーザーシステムの開発

今使っているレーザーシステムは二つの制限があ る。一つはポンプ光の繰り返し周波数を上がると、 熱蓄積が熱レンズ効果を引き起こす。厚み 0.5mm の Yb:YAG thin-disk 結晶について繰り返し 50Hz に 上がると増幅率及びビーム品質を悪くなっている。 この問題を解決するには冷却システムの改造が必要 である。もう一つは増幅するパルスの幅が約 30ps であり、パルスのピーク強度が強すぎ、それ以上に 増幅すると、非線形効果が起こり、波長・位相の変 調などの問題が生じてしまう。この問題を解決する ため、チャープパルス増幅 (Chirped pulse amplification: CPA)システムが必要である。した がって、最終運転条件を満たすため、新しいレー ザーシステムを開発している。

半導体 LD 励起方式は、すべて固体素子で構成さ れるため、レーザー媒質内部に発生する熱を大幅に 低減できる。従来の励起方式に比べ,高変換効率・ コンパクト化が可能であり、高品質ビームが得られ る。更に、長寿命・超安定な LD を用いた完全固体 化レーザーで、メンテナンスが容易である。 Nd:YAG 利得媒質には、Yb:YAG 媒質と同じ、LD 直接励起なので、構造簡単により、更なる高光学均 一性や耐力性を備え、高繰り返し高強度増幅に対応 できる。

しかし、Nd 系媒質の利得スペクトルが狭くて (~0.3 nm)、周波数領域の制御が難しくなる。 Phase II には高電荷量が目指して、レーザー光源の 増強することは中心として開発する。

一方、第三段階のビームコミッショニング
 (Phase III) について高強度と低エミッタンスを両
 方目指すので、Yb:YAG 利得媒質によって CPA 増幅システムの開発を行う。





Figure 4: Layout of Laser system.

Figure 4 によって、まず、市販の 114 MHz、中心 波長 1030 nm の Menlo 社発振器を導入した。バック アップとして、新全正常分散 ANDi (all normal dispersion)タイプ Yb ファイバー発振器を開発した。 シグナルパルスを中心波長 1030 nm と 1064 nm の成 分を分け、Yb:YAG 及び Nd:YAG 増幅を両方対応で きる。そして、旧レーザーシステムと同じように、 透過型回折格子ストレッチャー、SOA パルスピー カーおよびファイバー増幅システムを導入した。ス トレッチャーによる広帯域スペクトルパルスを中心 波長 1030 nm と中心波長 1064 nm によって二つに分 ける[4]。

1064 nm 成分シグナルは Yb ドップファイバーを 用いて増幅し、EO パルスピッカーによって Nd:YAG 固体再生増幅システムに入れる。こちらの 増幅システムは高強度パルスを目指す。一方、1030 nm 成分シグナルは Yb ドップ PCF ファイバーを用 いて増幅し、Yb:YAG 固体再生増幅システムに入れ る。今後に CPA システムも導入する予定である。

3.2 全正常分散 ANDi 型ファイバー発振器



Figure 5: ANDi type Oscillator.

全正常分散型ファイバー発振器は、共振器内での 回折格子などの分散補償素子を設けことなく、全正 常分散発振することである。パルスの広がりは、 モード同期の役割を担うスペクトルバンドパスフィ ルタによって補償される。Figure 5 によって、共振 器内に回折格子対を使用しないので、発振器の堅牢 性を増強し、内部ロスを抑制した。更に、発振器内 のシグナルパルスを正分散しか与えないので、パル ス列の安定性もアップした。発振器の繰り返し周波 数を 114.2 MHz (10.38*11 MHz)にセットした。そし て、繰り返し周波数 10.38 MHz の長共振器も開発し ている。

バンドパスフィルタの中心波長およびバンド幅に よって生成されたシグナルパルススペクトルを調整 できる。Figure 6 はいろんなバンドパスフィルタに おいて出力パルスのスペクトルの形である。



Figure 6: The spectrum of the oscillators.

3.3 1030/1064 nm ビームの仕切

Figure 7 のように、回折格子ストレッチャーに よって、回折格子対とエンドミラーの間に発振器か らのパルスを波長ごとに展開される。この中、中心 波長 1030 nm 幅 2 nm の成分と中心波長 1064 nm 幅 0.3 nm の成分が選択され、それぞれにファイバー増 幅に導入した。増幅した 1030 nm のパルス成分を Yb:YAG thin-disk 結晶増幅システムのシグナル光と して使われるが、増幅した 1064 nm のパルス成分を Nd:YAG Rod 結晶増幅システムのシグナル光として 使われる。



Figure 7: Grating stretcher

3.4 Nd:YAG Thin-disk 固体再生増幅システム

まず、増幅率を上げるため、光が利得結晶に繰り 返される再生増幅を行う。Figure 8 は ND:YAG リン グ型再生増幅共振器である。ダブルバンチを増幅す るため、共振器長が7 m 以上設置した。共振器内に 電気光学効果 Pockels Cell を用い、共振器内シグナ ルパルスを閉じ込め、利得飽和直後に取り出す。そ の後、更に高エネルギーを得るため、Nd:YAG マル チパス増幅システムに導入予定である。



Figure 8: Nd:YAG Rod regenerative amplifier

Nd:YAG 増幅システムには Phase II に対応するため、高強度出力光パルスを期待する。

3.5 Yb:YAG Thin-disk 固体再生増幅システム



Figure 9: Yb:YAG thin-disk regenerative amplifier

PCF ファイバー増幅した 1030 nm のシグナルパル スを Yb:YAG Thin-disk 再生増幅共振器(Figure9)に入 れる。

繰り返し周波数 50 Hz について、熱蓄積を避ける ため、新しい結晶クーリング用のヒートシンクを開 発し、はんだ付け方法も改善した。更に、ペルチェ 素子および真空チャンバーによって-23°まで Yb:YAG 結晶を冷却実験も行った。もっと詳しい報 告は[5]に掲載した。

Yb:YAG 増幅システムには最終の Phase III に対応 するため、高強度およびパルス幅が整形できるレー ザー光源を期待する。

4. まとめ

RF 電子銃を励起するため、Yb 系増幅媒質とする ハイブリッドレーザー光源を開発した。繰り返し周 波数 25 Hz に対して、安定な 1.3 nC の電子ビームが 得られた。Phase I ビームコミッショニングにむけて 運転している。

今後のビームコミッショニングのため、5 nC 程

度のバンチ電荷量生成できるおよび整形できるパル ス光源が必要である。したがって、Nd および Yb ドップ利得媒質を用いて、新しいハイブリットレー ザーシステムを開発している。

Yb ファイバー発振器から生成した広帯域シグナ ルを回折格子ストレッチャーによって、中心波長中 心波長 1064 nm 幅 0.3 nm の成分と 1030 nm 幅 2 nm の成分が選択され、それぞれに Nd:YAG 増幅システ ムと Yb:YAG 増幅システムに導入した。Phase II ビームコミッショニングにおいて、Nd:YAG 増幅シ ステムを開発し、高強度出力パルスを目指す。そし て、最終 Phase III ビームコミッショニングにおいて、 Yb:YAG 増幅システムを開発し、高強度出力パルス とパルス形の整調を両方目指す。

参考文献

- [1] M. Satoh et al., MOP060, "SuperKEKB 入射器コミ ッショニングの現状 (III)", in these proceedings.
- [2] X. Zhou, et al., THP115, "SuperKEKB RF 電子銃用
 25Hz と 50Hz レーザーシステムのアップグレード", 第 12 回加速器学会, 福井, 2015.
- [3] T. Natsui, et al., MOP064, "SuperKEKB 用 RF gun のコミッショニング状況", in these proceedings.
- [4] X. Zhou, et al., THPMY041, "Neodymium and Ytterbium hybrid solid laser of RF gun for SuperKEKB", IPAC16, Busan, Korea 2016.
- [5] R. Zhang, et al., TUP054, "Improvements of Stable and High Output Energy Laser System for RF-Gun at SuperKEKB Injector", in these proceedings.